

реализация – центральная проблема становления и устойчивого развития каждого коммерческого банка.

Формирование стратегии кредитной политики коммерческого банка носит первостепенный характер как для реализации и результатов кредитной деятельности банка, так и функционирования всего банка в целом. Формирование стратегии должно носить четко выраженный обоснованный поэтапный характер.

Под стратегией кредитной политики мы понимаем совокупность научно-обоснованных норм и правил, лежащих в основе выработки и принятия решения в области кредитования, определяющих как доходность кредитных операций, так и в целом на будущее финансовое состояние кредитной организации.

Построение стратегии обусловлено целым рядом факторов и ограничений как внешнего так и внутреннего порядка, в их числе главная цель кредитования, функциональной специализацией банка, региональными особенностями, развитием кредитных услуг и макроэкономической ситуацией в стране и т.д.

Для современной российской банковской системы характерен переход к политике дифференциации услуг по рынкам и клиентам, выработкой стратегических решений о сегментации рынка, о приемлемом для банка соотношении риска/доходности, об уровне ликвидности и т.д. Как правило, кредитные стратегии устойчивых банков в явном или неявном виде основаны на сочетании универсальности функций и операций банков с их отраслевой и региональной специализацией.

Опыт успешно работающих западных и отечественных банков показывает, что эффективная стратегия деятельности организации на конкурентном рынке определяется, как правило, сочетанием трех составляющих: - правильно выбранными долгосрочными целями;

- глубоким пониманием конкурентного окружения (внешней среды);
- реальной оценкой собственных ресурсов и возможностей кредитной организации, ее конкурентных преимуществ.

Учитывая совокупность факторов, обуславливающую кредитную деятельность банка, стратегия кредитной политики должна обозначить ориентиры, к которым должны стремиться коммерческие банки в долгосрочном периоде времени. Такими ориентирами, в частности, могут быть: доля выданных кредитов в общем объеме активов банка, предельный размер проблемных кредитов, лимиты сегментов кредитного портфеля и т.д. Так, установление кредитных лимитов, может включать лимиты на кредитование предприятий одной отрасли, одной формы собственности, одного вида кредитования и т.д., клиентские лимиты для акционеров, для клиентов с определенной кредитной историей, для новых клиентов, а также географические лимиты и др.

Кроме того, в стратегическом плане, кредитная политика должна определить конкретные требования к потенциальным заемщикам, предлагаемым к кредитованию бизнес-проектам и обеспечению кредитов. Иными словами, стратегический план кредитной политики устанавливает так называемые кредитные ог-

раничения. Эти ограничения могут быть установлены в отношении применения отдельных видов и форм предоставленных кредитов, в отношении отдельных форм обеспечения и т.д.

Совокупность вышеназванных ограничений позволяет определить направления размещения кредитных ресурсов также как и обозначить критерии отбора кредитных заявок. Не целесообразно рассмотрение кредитных заявок, не соответствующих требованиям банка, а именно попадающих под кредитные ограничения.

Таким образом, стратегия кредитной политики формирует те рамки, в которых должны приниматься все последующие управленческие решения. Для формирования эффективной стратегии необходимо использовать различные научно и практически обоснованные подходы, позволяющие учитывать главные и второстепенные внешние и внутренние факторы. Результатом формирования стратегии является долгосрочный стратегический план, отражающий систему новых программ деятельности кредитных подразделений банка и обеспечивающий достижение поставленных целей.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР ПОВЕРХНОСТИ GAAS(111) ПРИ КОАДСОРБЦИИ ЦЕЗИЯ И КИСЛОРОДА

Блиев А.П., Наконечников А.В.
*Северо-Осетинский государственный
университет им. К.Л. Хетагурова,
Владикавказ*

Физические и химические процессы происходящие на поверхности полупроводников при коадсорбции цезия и кислорода являются предметом исследования уже более 30 лет. Получаемые таким образом активированные поверхности GaAs широко используются не только в промышленной электронике, но также в атомной физике и физике высоких энергий. В последнее время поверхности с отрицательным электронным зарядом находят применение в качестве источников спин-поляризованных электронов. Несмотря на большое количество исследований, на данный момент остаются мало изученными полярные грани поверхности GaAs и происходящая на них адсорбция атомов щелочных металлов. Важность исследования интерфейсов GaAs (Cs, O) носит не только научный характер, но и является исключительно важной физико-технологической задачей.

Целью настоящей работы являлось исследование электронных свойств полярной грани GaAs(111) при адсорбции цезия и кислорода

Измерения энергетического спектра GaAs проводились методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS, $AIK_a = 1486,6$ эВ) и ультрафиолетовой электронной спектроскопии (UPS, $h\nu=60$ эВ). Атомарно-чистую поверхность арсенида галлия получали методом ионной бомбардировки. Одновременно контролировалось относительное изменение работы выхода на образцах методом электронного

пучка Андерсона. Адсорбцию цезия производили из стандартного источника.

Установлено, что наиболее значительные изменения работы выхода - в 2,75 эВ, достигаются при покрытиях поверхности в 0,5 монослоя атомов Cs. Дальнейшая адсорбция до 2 монослоев атомов цезия изменяет работу выхода на 0,25 эВ. Анализ спектров фотоэлектронной эмиссии показывает, что по мере увеличения степени покрытия поверхности атомами цезия растет интенсивность пиков фотоэлектронов, как As 3d, так и Cs 4d.

После стабилизации термодинамической работы выхода при адсорбции атомов Cs производилась адсорбция O₂ на поверхности GaAs(111). В процессе осаждения O₂ также контролировалась термодинамическая работа выхода. Общее изменение работы выхода при адсорбции O₂ составило 1,2эВ.

Уменьшение работы выхода после осаждения Cs происходит, на наш взгляд, вследствие осаждения электроположительного цезия на поверхности и увеличения изгиба зон вниз. Дальнейшее уменьшение работы выхода при адсорбции кислорода, очевидно, связано с образованием диполей Cs₂O, что также приводит к дальнейшему скачку потенциала вниз.

Таким образом адсорбция атомов Cs и O₂ в общей сложности изменяет работу выхода на 3,95 эВ. Такое снижение возможно, либо за счёт образования химической связи атомов цезия с поверхностными атомами и образования новых состояний, приводящих к возникновению положительного заряда на поверхности, либо за счёт поля диполей Cs₂O, образующихся при физической адсорбции.

Для определения механизма снижения работы выхода была исследована энергетическая структура поверхности валентной зоны GaAs(111) с помощью ультрафиолетовой электронной спектроскопии. Определено, что в запрещенной зоне никаких новых состояний не обнаружено. В то время как в валентной зоне происходит некоторое смещение пиков. При покрытиях же больше 1 Ленгмюр разрешимость пиков даже ухудшается и происходит их уширение по мере увеличения покрытия цезием. Это можно объяснить вкладом в спектр фотоэлектронов от адсорбата. Установлено, что по мере покрытия поверхности GaAs(111) атомами Cs и O₂ новых электронных состояний не образуется, а снижается лишь барьер на границе полупроводник-вакуум вследствие поля диполей Cs₂O.

СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ

Богомолов А.М., Портнова А.Г.

*Кемеровский государственный университет,
Кемерово*

Психологические защитные механизмы принято рассматривать как компенсаторно - приспособительные способы регуляции в общей структуре психической адаптации, связанные с индивидуально-личностными свойствами субъекта адаптации и характером адаптогенных факторов.

Действие защитных механизмов, обобщенно, выражается в бессознательном преобразовании субъективно значимой информации в целях снижения нервно-психического напряжения, поддержания интрапсихической устойчивости и согласованности личности, предотвращения дезорганизации психической деятельности.

Формирование системных качеств психологической защиты происходит в общем контексте формирования регуляторно-приспособительных свойств психики и функциональных систем, обеспечивающих возможность развития личности и сохранение ее психологического здоровья, в контексте хода психического созревания и развития личности.

На сегодняшний день исследования неосознаваемых адаптивных психических процессов в отечественной науке представлены возрастно - психологическим, структурно - функциональным, клинико-психологическим, психодинамическим и другими подходами.

На наш взгляд, перспективным является структурно-динамический анализ психологической защиты в рамках системного подхода, который, по мнению Е.С. Романовой, предполагает рассмотрение причинных и временных связей между всеми элементами, включенными в генезис и функционирование основных защитных механизмов (Романова Е.С., 2002).

Для описания психологической защиты, как реальной динамической системы, мы воспользовались идеей пентабазиса системных описаний, предложенной В.А. Ганзеном. Сущность метода базисов состоит в соотношении множества элементов описания с множеством элементов базиса, в результате чего производится структурирование и упорядочивание множества элементов описания.

Основными характеристиками любого объекта, по утверждению В.А. Ганзена, являются пространственные, временные, информационные и энергетические, которыми обладает субстрат объекта, выполняющий функцию интегратора перечисленных характеристик. Системное описание психологической защиты, ее основных свойств, на наш взгляд, включает анализ компонентов и отношений между ними, представленных в таблице ниже (см. таблицу). В основу выделения компонентов и их структуры положен системный подход к психологической защите Е.С. Романовой, базисное разложение системных объектов В.А. Ганзена и целостный подход к изучению человека Б.Г. Ананьева (Романова Е.С., 2002; Ганзен В.А., 1984; Ананьев Б.Г., 1968).